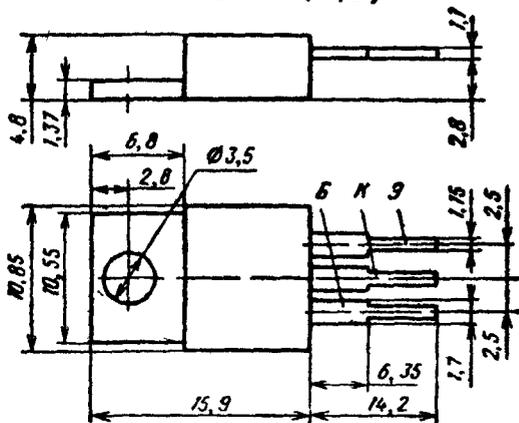


2Т884 (А, Б)

2Т884 (А, Б)

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* переклЮчательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=5$ В, $I_B=0,3$ А, не менее:

$T = +25^\circ\text{C}$	25
$T = +100^\circ\text{C}$	15
$T = -60^\circ\text{C}$	6

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_K=30$ мА, не менее 10 МГц

Граничное напряжение при $I_K=30$ мА, не менее:

2Т884А	400 В
2Т884Б	300 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=0,3$ А, $I_B=0,03$ А, не более 0,8 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=0,3$ А, $I_B=0,03$ А, не более 1 В

Время включения при $U_{КБ}=200$ В, $I_K=1$ А, $I_B=0,02$ А, не более 3 мкс

типичное значение 2* мкс

Время спада при $U_{КБ}=200$ В, $I_K=1$ А, $I_B=0,2$ А, не более 0,8 мкс

типичное значение 0,6* мкс

Время рассасывания при $U_{КБ}=200$ В, $I_K=1$ А, $I_B=0,2$ А, не более 3 мкс

типичное значение 2* мкс

Обратный ток коллектора при $U_{КБ}=U_{КБ,макс}$, не более:

$T = -60 \dots +25^\circ\text{C}$ 0,2 мА

$T = +100^\circ\text{C}$ 1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=5$ В, не более 1 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}=5$ В, не более 60 пФ

типичное значение 35* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ}=0,5$ В, не более 1500 пФ

типичное значение 1200* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база при $dU_{КБ}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т884А 800 В

2Т884Б 600 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{\theta} \leq 100$ Ом, $dU_{КБ}/dt \leq 250$ В/мкс:

2Т884А 800 В

2Т884Б 600 В

Постоянное напряжение база — эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 2 А

Импульсный ток коллектора 5 А

Постоянный ток базы 1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_{*} = -60 \dots +25^\circ\text{C}$:

с теплоотводом 15 Вт

без теплоотвода 1 Вт

Температура *p-n* перехода $+150^\circ\text{C}$

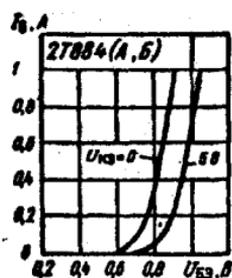
Температура окружающей среды $-60^\circ\text{C} \dots T_{*} = +100^\circ\text{C}$

¹ При $T_{*} = +25 \dots +100^\circ\text{C}$ $P_{К,макс}$ снижается линейно на 0,12 Вт/°C с теплоотводом и на 8 мВт/°C без теплоотвода.

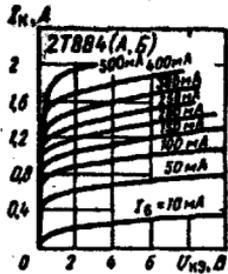
Допустимое значение статического потенциала 1 кВ.

Допускается обрезка выводов транзистора не ближе 5 мм от корпуса, односторонний изгиб выводов на угол не более 90° от первоначального положения в плоскости, перпендикулярной основанию корпуса, и не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм; при этом должны приниматься меры исключающие передачу усилия на корпус.

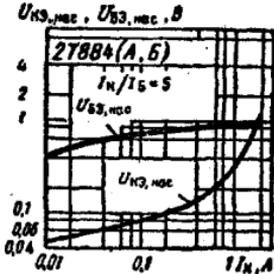
Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 5 мм. При одновременной пайке теплопроводящей поверхности и выводов транзистора пайку осуществлять припоем с температурой не более +260°C в течение не более 3 с. При отдельной пайке теплопроводящей поверхности и выводов транзистора пайку осуществлять припоем с температурой не более +240°C в течение не более 8 с; при этом обязательно применение теплоотвода.



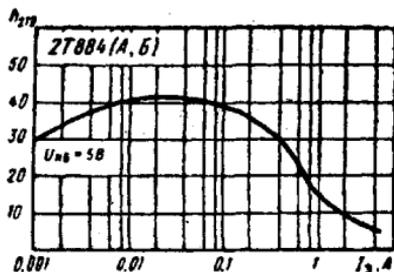
Входные характеристики



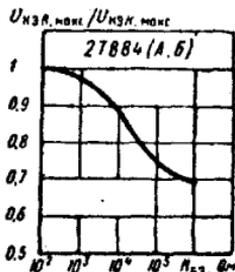
Выходные характеристики



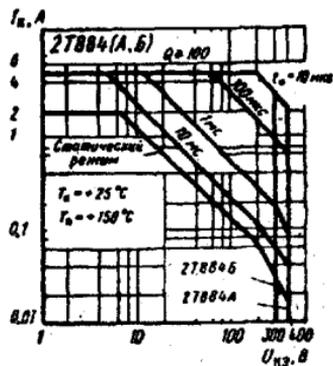
Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора



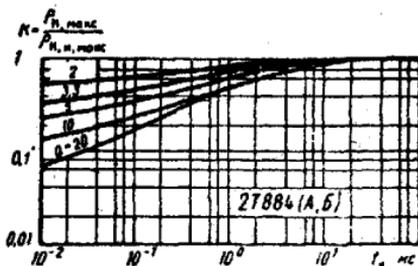
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Области максимальных режимов



Зависимость коэффициента K от длительности импульса